2SC1346, 2SC1347

シリコン NPN エピタキシアルプレーナ型/Si NPN Epitaxial Planar

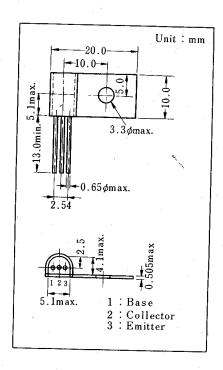
低周波出力増幅用/AF Output Amplifier 2SA730, 2SA731 とコンプリメンタリ/Complementary Pair with 2SA730, 2SA731

特 徵/Features

- ullet コレクタ・エミッタ飽和電圧が低い。 $ot / Low V_{ ext{OE(sat)}}$
- 2SA730, 2SA731 とコンプリメンタリペアで出力 1 W が得られます。/ 1 W output in complementary pair with 2SA730, 2SA731.

最大定格/Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C)

Unit	Value	Symbol	1	Item	
	30	37	2SC1346	コレクタ・	
. V	60	$ m V_{CBO}$	2SC1347	ベース電圧	
	25	7.7	2SC1346	コレクタ・	
V	50	V_{CEO}	2SC1347	エミッタ電圧	
V	5	V_{EBO}	- ス電圧	エミッタ・ベー	
A	1	I _{CM}	タ電流	せん頭コレクタ	
mA	500	$I_{\rm C}$		コレクタ電流	
m W	600	$P_{\mathbf{C}}$	37)	コレクタ損失 放熱板付(No.	
°C	125	T_{j}		接合部温度	
°C	$-55\sim +125$	T _{stg}		保存温度	



電気的特性/Electrical Characteristics (Ta=25°C)

Item	1	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタ・ ベース電圧 2SC1346 2SC1347	2SC1346	. 37	-	30	3, 2.	max.	Offic
	2SC1347	V_{CBO}	$I_{\rm C} = 10 \mu A$, $I_{\rm E} = 0$	60			v
	2SC1346		$I_C=10$ mA, $I_B=0$	25		-	
	2SC1347	V_{CEO}		50			v
エミッタ・ベー	ス電圧	$V_{\rm EBO}$	$I_{\rm E} = 10 \mu {\rm A}, \ I_{\rm C} = 0$	5			
コレクタしゃ断	電流	I_{CBO}	$V_{\rm CB} = 20V, I_{\rm E} = 0$			0.1	$\frac{\mathbf{v}}{\mu \mathbf{A}}$
直流電流増幅率	h_{FE1}	$V_{\rm CE} = 10V, I_{\rm C} = 150 \rm mA$	60	160	340	μΑ	
	h_{FE2}	$V_{\rm CE} = 10V, I_{\rm C} = 500 {\rm mA}$	40	90	010		
コレクタ・エミ	ッタ飽和電圧	V _{CE(sat)}	$I_{\rm C} = 500 \rm mA$, $I_{\rm B} = 50 \rm mA$		0. 35	0.6	v
ベース・エミッ	タ飽和電圧	V _{BE(sat)}	$I_{\rm C}$ =500mA, $I_{\rm B}$ =50mA	- 2	1.1	1.5	
・トランジション	司波数	$f_{\mathbf{T}}$	$V_{CB}=10V$, $-I_{E}=50$ mA		200	1.0	MHz
コレクタ出力容量	Ĭ. Ĭ.	C _{ob}	$V_{CB}=10V$, $I_{E}=0$, $f=1MHz$	-	6	15	pF

詳細は 318 頁 (2SC1317, 2SC1318, 2SC1346, 2SC1347) をご参照ください。 Details refer to page 318 (2SC1317, 2SC1318, 2SC1346, 2SC1347).